

【半導體製程設備實驗室-】

楠梓校區大仁樓 6106、6107-半導體製程設備培訓實驗室

設備名稱	數量	單位	規格
電漿促化學汽相沉積系統	1	台	高敦/電漿輸出功率瓦數 $\geq 300\text{W}$ 及自動阻抗匹配器x1組、載臺加溫 200°C 、真空可至 $1*10^{-3}\text{ mbar}$
反應離子蝕刻機	1	台	SamCo. RIE-10NR，可蝕刻多種材料. 如: Si, SiO ₂ , SiN, Poly-Si, GaAs, Mo, Pt, Polyimide等
濺鍍機系統	1	台	高敦/2支3英吋濺鍍槍(直流瓦數： $\geq 2000\text{ W}$ 、射頻瓦數： $\geq 750\text{ W}$)、產生器輸出功率瓦數 $\geq 300\text{W}$ 及自動阻抗匹配器x 1組、直流電漿電源產生器功率輸出 $\geq 1000\text{ W}$ 至少1組
原子層沉積系統	1	台	高敦/載台溫度可達 300 C 、電漿輸出功率瓦數 $\geq 600\text{ W}$
熱蒸鍍機系統	1	台	高敦/7V/250A電源供應器，可分別提供給至少3個金屬蒸鍍鍋舟、4吋載台轉速可調 5-25 rpm
曝光機	1	台	科毅-半自動機台、線寬 $1\text{ }\mu\text{m}$



原子層沉積系統 Atom Layer Deposition (ALD)



電漿促化學汽相沉積系統 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)



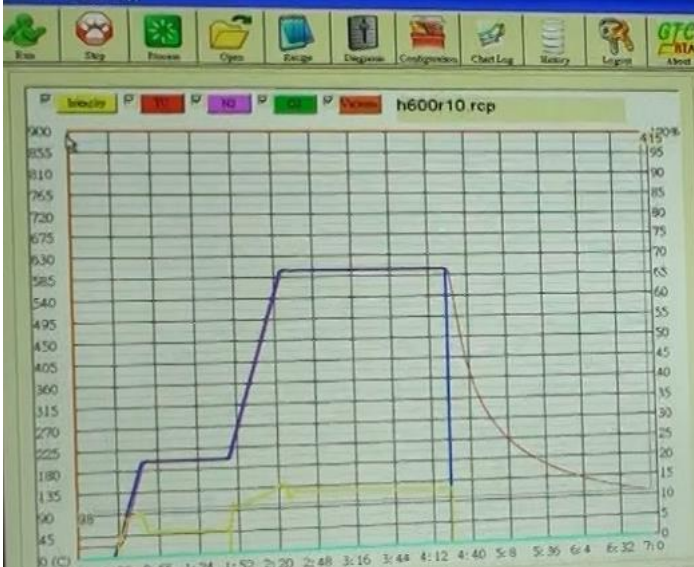
熱蒸鍍機 Thermal Evaporator



濺鍍機 Sputter



快速退火爐 Rapid Thermal Annealing (RTA)





【電漿離子蝕刻機】



臭氧清洗機

